

慶應義塾大学試験問題 物理学 D (一斉)

2013 年 2 月 1 日 (金) 2 時限 (試験時間 50 分) 問題用紙 回収不要

担当者 小原、神成、高野、福岡

注意: とくに指示がない場合、答案には結果のみならず、それを導いた過程についても記すこと。
また、万一与えられた条件だけでは解けない場合には、適当な量を定義したり、条件を明記した上で解いてよい。ただし、電気定数 (真空の誘電率) ϵ_0 、磁気定数 (真空の透磁率) μ_0 、真空中の光速 c の記号は断りなしに使ってよい。

問題 I 同じ中心もつ半径 a および半径 b の球殻を両極板とするコンデンサーがある ($a < b$)。この中心を位置ベクトルの原点とする。両極板の間の空間は誘電体で満たされており、その誘電率は、中心からの距離 r の関数として、 $\epsilon(r) = \bar{\epsilon}\epsilon_0 \left(\frac{b}{r}\right)^4$ で与えられている。ここで、 $\bar{\epsilon}$ は $\bar{\epsilon} > 1$ を満たす定数である。内側の電極に Q の外側の電極に $-Q$ の電荷を与える (図 I 参照)。

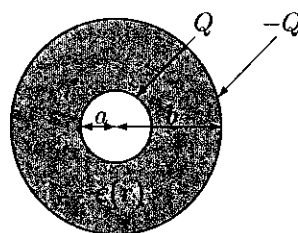


図 I

- (1) 両極板間の位置 r における電界 $E(r)$ 、電束密度 $D(r)$ 、電気分極 $P(r)$ を求めなさい。
- (2) コンデンサーの電気容量を求めなさい。
- (3) 誘電体の内側の表面上の位置 $r(|r| = a)$ における分極電荷面密度 $\omega_P(a)$ および誘電体の外側の表面上の位置 $r(|r| = b)$ における分極電荷面密度 $\omega_P(b)$ を求めなさい。
- (4) 両極板間の中心からの距離 r が $r_1 \leq r \leq r_2$ の範囲の分極電荷 $q_P(r_1, r_2)$ を求めなさい。ただし、 $a < r_1 < r_2 < b$ とする。

問題 II 物質中で、電界を E 、電束密度を D 、磁束密度を B 、磁界を H 、真電荷密度を ρ_t 、真電流密度を i_t とする。

- (1) 物質中のマクスウェル方程式を書きなさい。
- (2) デカルト座標系 (x, y, z) を用い、 x, y, z 軸の正の方向の単位ベクトルを、それぞれ、 e_x, e_y, e_z とする。 $\rho_t = 0, i_t = 0$ で、時刻 t 、位置 (x, y, z) において $E(x, y, z, t) = E_x(z, t)e_x, B(x, y, z, t) = B_y(z, t)e_y$ と与えられる平面電磁波を考える。 $E_x(z, t)$ の従う波動方程式と、その一般解を書きなさい。この一般解を用いて、 $B_y(z, t)$ がどのように表されるか書きなさい。また、時刻 t 、位置 (x, y, z) におけるポインティングベクトル $S(x, y, z, t)$ を求めなさい。
ヒント: 一般解には、2 回以上微分可能な 2 つの任意の関数 $f(\xi), g(\eta)$ を用いると良い。

問題 III 半径 a で無限に長い円柱状の導体がある。導体の外側には、導体と同軸で、内半径 $b(>a)$ 、外半径 $d(>b)$ で無限に長い円筒状の磁性体がある (図 III-1 参照)。導体円柱、磁性体円筒の中心軸を z 軸にとり、 z 軸に垂直な平面内の位置を 2 次元極座標 (r, φ) で表した円柱座標系 (r, φ, z) を用いて考える。 z 軸の正の向きの単位ベクトルを e_z とする。位置 (r, φ, z) において、 z 軸に垂直で z 軸から遠ざかる方向の単位ベクトルを e_r 、 z 軸を中心に回転する方向 (右ねじが e_z 方向に進む方向) の単位ベクトルを e_φ とする (図 III-2 参照)。互いに直交するこれらの単位ベクトル e_r, e_φ, e_z を用いて位置 (r, φ, z) におけるベクトル量を表す。磁性体は $b < r < d$ の領域にあり、磁性体の透磁率は r の関数として $\mu(r) = \bar{\mu}\mu_0 \frac{r}{b}$ で与えられている。ここで、 $\bar{\mu}$ は $\bar{\mu} > 1$ を満たす定数である。磁性体のない領域の透磁率は μ_0 である。導体に e_z 方向に大きさ I の定常電流を一樣に流す。

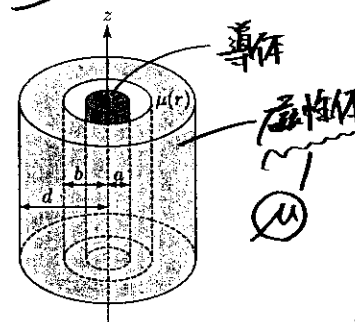


図 III-1

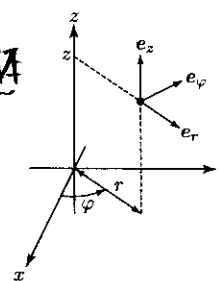
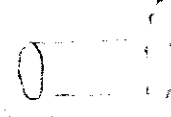


図 III-2

- (1) 位置 (r, φ, z) における磁束密度 $B(r, \varphi, z)$ 、磁界 $H(r, \varphi, z)$ 、磁化 $J(r, \varphi, z)$ を求めなさい。
- (2) 磁性体の内側の表面上の位置 $(r = b, \varphi, z)$ における面磁化電流密度ベクトル $I_m(b, \varphi, z)$ と磁性体の外側の表面上の位置 $(r = d, \varphi, z)$ における面磁化電流密度ベクトル $I_m(d, \varphi, z)$ を求めなさい。
- (3) $z = \text{一定}$ の平面内の $0 \leq r \leq r_1, 0 \leq \varphi < 2\pi$ で指定される円形の範囲を e_z 方向に貫く磁化電流 $I_m(r_1)$ を求めなさい。 $b < r_1 < d$ とする。
ヒント: i_m を磁化電流密度とすると、 $\text{rot} J = \mu_0 i_m$ の積分形を考える。あるいは、 B に関するアンペールの法則 (積分形) で、全電流から真電流の寄与を差し引く。
- (4) 位置 (r, φ, z) における磁化電流密度 $i_m(r, \varphi, z)$ を求めなさい。 $b < r < d$ とする。
ヒント: (3) の結果を用い、 $z = \text{一定}$ の平面内の $r_1 \leq r \leq r_1 + \Delta r_1, 0 \leq \varphi < 2\pi$ で指定される円環の範囲を e_z 方向に貫く磁化電流 $I_m(r_1 + \Delta r_1) - I_m(r_1)$ を求め、円環の面積で割る。あるいは、デカルト座標 (x, y, z) においては、 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $e_r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, 0\right)$ 、 $e_\varphi = \left(-\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, 0\right)$ 、 $e_z = (0, 0, 1)$ と表されることを用いる。

問題 IV 真空中に、半径 r_1 で単位長さあたりの巻き数 n_1 のソレノイド 1 と、半径 r_2 の単位長さあたりの巻き数 n_2 のソレノイド 2 が、中心軸を共通にして配置されている。 $r_1 < r_2$ である。

- (1) ソレノイド 1 に大きさ I_1 の電流を、ソレノイド 2 に大きさ I_2 の電流を同じ向きに流したとき、ソレノイド 2 の内側の空間の単位長さあたりに蓄えられる磁界のエネルギー U_m を、磁界のエネルギー密度を用いて求めなさい。
- (2) ソレノイド 1 の単位長さあたりの自己インダクタンス \mathcal{L}_{11} 、ソレノイド 2 の単位長さあたりの自己インダクタンス \mathcal{L}_{22} およびソレノイド 1 とソレノイド 2 の単位長さあたりの相互インダクタンス \mathcal{L}_{12} を求めなさい。



$$\mu_0 n_1 n_2 (I_1 + I_2)^2$$